

公司代码：688785

公司简称：恒运昌

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币260,573,073.69元。公司2025年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本67,701,688股，以此计算合计拟派发现金红利54,161,350.40元(含税)。本年度公司现金分红总额54,161,350.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.58%。

上述事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议，尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	恒运昌	688785	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄丽华	孙天园
联系地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋
电话	0755-23596099	0755-23596099
传真	0755-27813086	0755-27813086
电子信箱	IR@csl-vacuum.com	IR@csl-vacuum.com

2、报告期公司主要业务简介

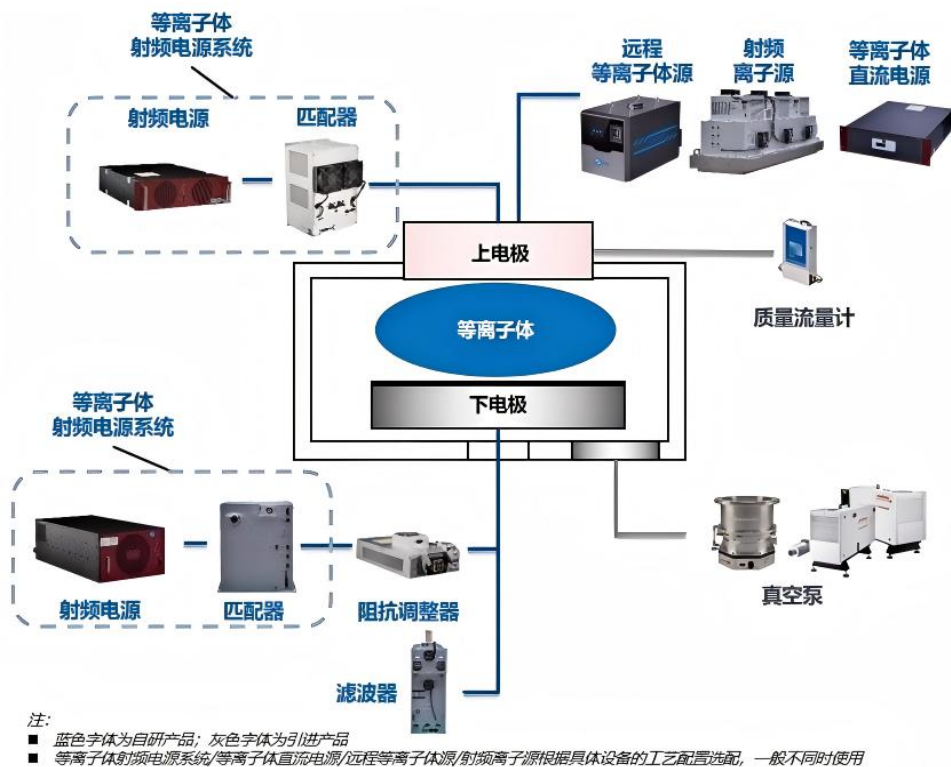
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主营业务情况

公司是国内领先的半导体设备核心零部件供应商，主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务，并引进真空获得和流体控制等相关的核心零部件，围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。

2. 主要产品及服务情况

公司主要围绕等离子体工艺打造产品矩阵，自研产品具体包括等离子体射频电源系统（等离子体射频电源及匹配器）、等离子体激发装置（远程等离子体源、射频离子源）、等离子体直流电源、配件（滤波器、阻抗调整器等）；引进产品主要包括真空获得和流体控制分别所需的真空泵、质量流量计等核心零部件；同时还为晶圆厂提供等离子体射频电源系统原位替换及维修等技术服务。



(1) 自研产品

1) 等离子体射频电源系统

历经十二年，公司通过自研先后迭代推出 CSL、Bestda、Aspen/Basalt、Cedar 四代等离子体射频电源系统系列产品，其中 Bestda 系列、Aspen/Basalt 系列及 Cedar 系列产品主要面向半导体领域，具体如下：

① Cedar 系列

项目	Cedar 系列
产品类型	Cedar 系列等离子体射频电源系统
图示	



产品特征及优势	<ul style="list-style-type: none"> • 射频电源及匹配器的一体机 • 配备四个中心阻抗应用，可固定匹配且无匹配时间损失 • 全新高速控制平台，实现复杂波形控制 • 快速数据及大数据采集功能，导出设备底层基础数据 • 基于陶瓷基板高可靠性匹配设计 • 具备时钟芯片及增强运维能力，支持在线分析，查看运行日志及指令交互功能
制程情况	该系列产品可支持 5 纳米及以下半导体制程，验证中

② Aspen/Basalt 系列

项目	Aspen/Basalt 系列	
产品类型	Aspen 系列等离子体射频电源	Basalt 系列匹配器
图示		
产品特征及优势	<ul style="list-style-type: none"> • 标准 Halfrack/fullrack 设计 • 具备脉冲、相位同步、BVC、HALO 等高级功能 • 扫频匹配时间小于 10ms • 串口/模拟口响应时间小于 2ms/10ms • 脉冲频率范围 10Hz-20kHz 	<ul style="list-style-type: none"> • 内置闭环控制步进马达，结合智能匹配算法，提供快速、精确可靠的阻抗匹配 • 内置 V/I 传感器，实时检测负载工作状态 • 单频/双频/双输出/手动/自动可选 • 具备功率分配功能
制程情况	该系列产品可支持 7-14 纳米半导体制程，已量产	

③ Bestda 系列

项目	Bestda 系列	
产品类型	Bestda 系列等离子体射频电源	Bestda 系列匹配器

图示		
产品特征及优势	<ul style="list-style-type: none"> • 具备自动扫频匹配、CEX、脉冲等高级功能 • 水冷风冷两种冷却方式 • 扫频匹配时间小于 100ms • 串口/模拟口响应时间小于 50ms/100ms • 脉冲频率范围 10Hz-10kHz 	<ul style="list-style-type: none"> • 全数字化测量和控制系统，集成智能算法 • 内置 V/I 传感器，实时检测输入和负载阻抗 • 单频/双频/双输出/手动/自动可选 • 全面的保护机制
制程情况	该系列产品可支持 28 纳米半导体制程，已量产	

④ CSL 系列

项目	CSL 系列	
产品类型	CSL 系列等离子体射频电源	CSL 系列匹配器
图示		
产品特征及优势	<ul style="list-style-type: none"> • 实时功率和阻抗测量主动前面板，方便监控工作状态及进行设置 • 允许 12 台电源工作在相同的频率和相位，输出到同一等离子体腔体 	<ul style="list-style-type: none"> • 步进马达驱动真空电容，提供快速、精确、可靠的阻抗匹配 • 内置 V/I 传感器，驻波测量调节输出幅度和相位 • 相位/幅度灵敏度选择装置，提供低反射功率和快匹配速度之间的选择 • 带多级抽头的并联和串联电感，提供宽的匹配范围
应用领域	广泛应用于光伏电池片薄膜沉积、显示面板镀膜、精密光学镀膜、工业级等离子体清洗、其他工业级真空镀膜等环节。	

⑤ 公司等离子体射频电源系统的主要应用领域

公司的等离子体射频电源系统被广泛应用于半导体工艺中的薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶、键合等环节，以及光伏电池片的薄膜沉积、显示面板镀膜、精密光学镀膜、常压等离子体清洗等工业生产环节，应用领域具体如下：

行业领域	半导体领域	非半导体领域
------	-------	--------

工艺流程	薄膜沉积	刻蚀	离子注入	清洗去胶	键合	真空镀膜	等离子体清洗
设备类型	PVD、PECVD、PEALD、LPCVD、HDPCVD 等设备	ICP 刻蚀机、CCP 刻蚀机	离子注入机	去胶机	键合设备	PECVD、PEALD、PVD 等设备	等离子体清洗机

2) 其他自研产品及配件

除自研的等离子体射频电源系统外，公司其他自研产品包括：①电源类产品：等离子体直流电源等；②等离子体激发装置：远程等离子体源、射频离子源；③配件：等离子体射频电源功率计、滤波器、阻抗调整器等，具体如下：

项目	其他自研产品及配件			
应用场景	半导体、光伏、显示面板、精密光学等领域中的薄膜沉积、镀膜、等离子体清洗			
产品	定义	产品系列	图示	产品特征及优势
电源类				
等离子体直流电源	能够输出恒定直流电压和电流，通过直流电压产生和维持等离子体的工艺电源	Ginkgo 系列、Maple 系列		1、产生高密度的直流功率，应用于半导体制造中金属等导电材料的溅射镀膜等工艺环节 2、直流电源的输出能力与负载特性相互影响，电源的研制难点包括负载匹配、电弧管理、复杂脉冲等诸多方面 3、在拓扑结构、效率提升、适应工艺阶段的输出要求、提供稳定的工作环境等方面具有较好的表现 4、可实时地实现各种数字信号处理算法，提高了抑弧检测的灵敏度和准确度，实现了直流电源对高效及宽输出的应用要求
等离子体激发装置				

<p>远程等离子体源</p>	<p>一种用于产生等离子体的装置，其特点是等离子体的产生腔与晶圆所在的反应腔隔离，故名“远程”。其在一个专门的产生腔室中通过等离子体射频电源系统将气体电离形成等离子体，并将产生的等离子体传输到晶圆所在的反应腔</p>	<p>Torrent 系列</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、等离子体产生腔与晶圆所在的反应腔隔离，不直接接触待处理的晶圆等材料表面，可减轻设备工艺套件的磨损，实现对表面的均匀处理 2、对一些敏感的表面或者材料，可以有效降低对晶圆等材料表面的轰击、化学和热损伤，提升了工艺性能和灵活性
<p>射频离子源</p>	<p>一种由一个或多个等离子体射频电源、匹配器及感应线圈等组成的用于激发等离子体的模块化装置，大多应用在工业中的大尺寸镀膜中</p>	<p>ICP 系列、CCP 系列</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、模块化设计，每组两个发射天线，可分配电流比例，组内和组间电流可调节 2、叠加附属磁场设计，提供极佳的均匀性 3、工艺区间按需定制，长度可拓展
<p>主要配件</p>				
<p>滤波器</p>	<p>一种由多阶 LC 滤波电路组成的射频滤波装置，大多应用在半导体加热盘输入端，用于射频隔离、稳定射频等离子体的阻抗</p>	<p>Calamus 系列</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、多频率滤波设计，目标频率的高阻抗，高衰减设计 2、电路模块化，高密度机械结构灵活化设计
<p>阻抗调整器</p>	<p>一种由高频阻抗可调电路和低频谐振低阻抗电路组成的阻抗可调装置，大多应用在半导体等离子体腔体内硅片托盘的阻抗调整，控制等离子体托盘的接地阻抗</p>	<p>Granite 系列</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、多频率阻抗控制设计 2、集成输入电压电流实时监控 3、电路模块化，高密度机械结构灵活化设计

(2) 引进产品

公司基于等离子体发生条件和反应腔真空环境的实际需求，引进用于获得和维持真空环境的真空泵、用于流体精确控制的质量流量计以及用于真空镀膜装备的等离子体直流电源等核心零部件，围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案，打造核心零部件供应平台，具体如下：

类型	产品	示意图	具体功能	引进品牌
真空获得	真空泵		在反应腔获取真空环境的核心零部件，用于在反应腔中产生、改善和维持真空环境。主要包括干泵、分子泵、低温泵三大类，在薄膜沉积、刻蚀、离子注入等对真空环境要求较高的干法工艺中应用广泛	品牌 S(日本)、品牌 L(德国)
流体控制	质量流量计		反应腔供气系统的核心零部件，用于对气体等进行质量流量测量和控制，要求响应速度快、精确度高、稳定性好、耐腐蚀性好、使用寿命长。应用工艺包括薄膜沉积、刻蚀、离子注入等	品牌 M(日本)、品牌 F(日本)
真空镀膜	等离子体直流电源		在反应腔内使用等离子体直流电源对靶材施加电压，使气体离子化，产生等离子体。这些离子在电场的作用下加速并轰击靶材，溅射出原子或分子，最终沉积在基材上，完成镀膜。	品牌 A(德国)

(3) 技术服务

公司技术服务主要系为晶圆厂提供等离子体射频电源系统原位替换及维修服务。等离子体射频电源系统在晶圆厂使用过程中会出现老化、故障等问题，需要及时更换或维修。国内主要晶圆厂被美国商务部列入实体清单后，无法继续向原海外设备供应商采购备件或申请维修服务，公司为此承接了进口等离子体射频电源系统的原位替换及维修业务，为国内晶圆厂的稳定运转和生产可持续性提供了坚实的保障。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售，通过向半导体、光伏、显示面板、精密光学、其他工业等领域的客户销售以等离子体射频电源系统为代表的自研产品，以及引进真空泵、质量流量计等真空获得和流体控制相关的核心零部件，同时公司为晶圆厂和设备商提供等离子体射频电源系统原位替换及维修服务，以此实现收入和利润。

2、采购模式

公司等离子体射频电源系统等自研产品所使用的主要原材料包括电容、电阻、芯片等电子元器件、功率模块等电气件以及钣金件等结构件。公司在研发过程中结合技术参数、客户要求、物料来源等因素综合考量原材料的选型，通过有针对性的研发设计调整，不断提高产品的性能和品质。同时，公司在采购中积极推进国产化率的提升，注重使用本土元器件，以促进国产替代。

公司引进产品主要采购真空泵、质量流量计等真空获得和流体控制相关的核心零部件，公司根据客户需求向相关品牌的境内外供应商采购，其中境外供应商直接发货至公司指定港口，由公司办理清关等事宜；境内供应商发货至公司指定地点。

公司物料需求部门基于安全库存或销售预测的计划需求，提出采购申请。采购部门根据审批后的采购申请，结合原材料的耗用情况、价格波动、使用频率等多方面因素与合格供应商签订单次采购合同或年度框架协议，执行采购计划。

公司已建立稳定、高质量的供应商体系，关注供应商经营资质、生产能力、技术水平、质量管控水平以及产品价格等多方面因素，并结合响应速度、付款条件等对供应商进行综合评定，将符合要求的供应商列入合格供应商名录，并在供货阶段实行供应商动态管理，筛选优质供应商，持续优化采购渠道，提高原材料供应的效率和稳定性。

3、生产模式

公司等离子体射频电源系统等自研产品主要采取以销定产的生产模式，根据供货要求、产品生产周期、销售预测等因素对生产排期和物料管理进行统筹安排，协调生产、采购和仓储等相关部门保障生产的有序进行。公司的生产流程主要是部件加工及装配、软件烧录、检测和工艺调试等，由制造中心对原材料进行装配、线路连接、产品测试，确保产品性能稳定之后封装入库。为提升生产效率，公司将少量工序委外加工，包括PCBA和线缆定制工序。

4、销售模式

公司产品销售采取直销模式，下游客户主要为半导体、光伏、显示面板、精密光学等行业的设备商，公司向其直接销售与设备配套的等离子体射频电源系统等自研产品，以及真空泵、质量流量计等引进产品。对于等离子体射频电源系统等自研产品，公司需经过客户严格的调查评估、验厂考察等认证程序，才能进入客户的合格供应商体系或目录。在与客户合作对接过程中，公司销售、研发、工艺等部门与客户开展深入沟通，洽谈和确定客户需求信息，拟定合适方案；同时，品质部门、采购部门、生产部门也会参与客户产品的开发，根据新产品的特殊需求，优化产品布局 and 结构并达成最终方案。公司根据正式订单及客户预测相结合的方式生产排产，并按交货期向客户交付。对于真空泵、质量流量计等引进产品，公司根据客户具体需求和订单约定向客户直接销售引进产品。

5、研发模式

公司的研发由研发中心组织，具体包括研发项目的立项、项目实施及验证、交样结题及项目结案等。公司研发模式主要系结合客户主要制程与研发方向需求，同时以公司产品种类和系列为基础进行研发创新。在完成研发样品后，公司会及时向客户进行送样测试，并依据测试反馈结果以及客户提出的新需求，对产品的性能、参数和指标进行针对性调整。

2.3 所处行业情况

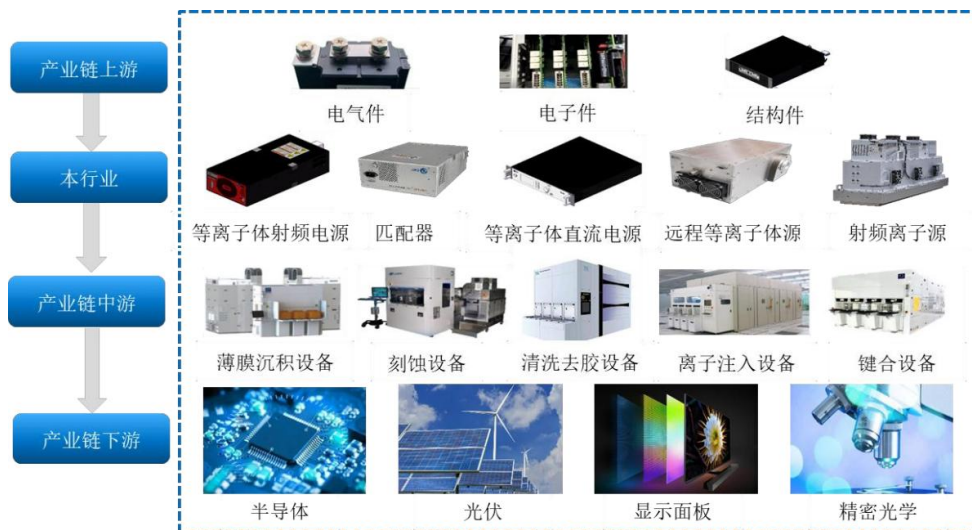
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司致力于为国产半导体设备提供优质核心零部件，主要产品为等离子体射频电源系统，主要应用于半导体设备领域。

(1) 行业的发展阶段、基本特点

等离子体射频电源系统行业

等离子体射频电源系统是半导体制造中极其关键的专用电源系统，主要由等离子体射频电源和匹配器组成。其核心作用是通过产生高频电场，在晶圆反应腔体内将特定工艺气体电离，创造并维持高活性、高能量的等离子体，并利用等离子体的特殊性能实现薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶、键合等复杂半导体工艺（薄膜沉积、刻蚀与光刻并称为芯片制造三大关键工序）。等离子体射频电源系统的性能直接影响薄膜沉积、刻蚀等环节中等离子体的成分浓度、均匀性和稳定性等，对于薄膜沉积的厚度、密度、应力、速率，以及刻蚀的选择性、方向性、速率、质量等至关重要，进而影响晶圆制造工艺的能力、良率和效率，等离子体射频电源系统在半导体制造核心装备中占据着核心位置。等离子体射频电源系统可广泛应用于半导体、光伏、显示面板、精密光学、等离子体清洗等领域，是推动工艺和技术进步的重要载体。产业链具体情况如下：



等离子体射频电源系统是半导体设备零部件国产化最难关卡之一，技术壁垒高、研发投入大、研发周期长、生产的“精确复制”要求极高，因而国产化率极低。中国大陆半导体行业等离子体射频电源系统的市场仍呈现由美系海外巨头厂商高度垄断的竞争格局，半导体设备厂商对于零部件自主可控的要求愈发紧迫，伴随国产替代的整体趋势，国产等离子体射频电源系统市场快速发展。

(2) 主要技术门槛

半导体设备核心零部件是半导体设备技术更迭和制程演进的重要承载，在半导体工艺和芯片结构日趋复杂的背景下，半导体设备商对核心零部件厂商的要求更为严苛，包括对产品的可靠性、稳定性和一致性及核心零部件厂商的研发能力、技术实力。因此，半导体设备核心零部件行业的技术壁垒很高。等离子体射频电源系统作为薄膜沉积设备、刻蚀设备等半导体设备的核心零部件，技术要求极高，包括在纳米尺寸级别上精准控制等离子体的刻蚀过程、在纳秒时间级别上和复杂环境中精准且稳定的控制等离子体的变化。技术要求极高主要由于其直接关系到薄膜沉积、刻蚀等环节中等离子体的浓度、均匀性和稳定性等，进而影响晶圆制造工艺的能力、良率和效率。

等离子体射频电源系统的研发难度大，所需研发周期长、研发投入大。以 AE 为例，从 2008 年推出可用于 FinFET 工艺的第三代 Paramount 系列射频电源，到 2023 年推出可用于 3D 封装的第

五代 eVerest 系列射频电源，产品迭代历时 15 年。MKS 年报披露其 2023-2025 年累计研发费用高达 8.58 亿美元。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的半导体设备核心零部件供应商，主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务，并引进真空获得和流体控制等相关的核心零部件，围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。公司自主研发的第二代产品 Bestda 系列等离子体射频电源系统可支撑 28 纳米制程，第三代产品 Aspen 系列等离子体射频电源系统可支撑 7-14 纳米先进制程，第四代产品 Cedar 系列等离子体射频电源系统将射频电源和匹配器整合为一体化平台，可支撑 5 纳米及以下更先进制程。公司在国内半导体领域系首家出货过亿元和首家实现等离子体射频电源系统（支持半导体先进制程）量产的国产厂商。公司打破多年来海外巨头在国内等离子体射频电源系统领域的垄断格局，能与海外巨头同台竞争，并不断扩大市场占有率。报告期内，公司获得深圳 2025 年瞪羚企业等荣誉。

根据弗若斯特沙利文历史统计数据，中国大陆半导体行业等离子体射频电源系统的市场呈现海外巨头高度垄断的竞争格局，其中 2024 年海外厂商 MKS、AE、霍廷格和 DAIHEN 等合计市占率接近 88%，国产厂商市占率不足 12%。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

根据 2025 年 10 月中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议所提出的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，要全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，提高基础研究投入比重，加大长期稳定支持。强化科学研究、技术开发原始创新导向，优化有利于原创性、颠覆性创新的环境，产出更多标志性原创成果。

1) 半导体工艺和芯片结构日趋复杂，对等离子体射频电源系统的技术要求显著提升

随着半导体制程的持续演进，薄膜沉积、刻蚀等半导体工艺的复杂度和精细度日益提高，对等离子体射频电源系统也在不断提出更高、更复杂的要求。经过几十年的演进，等离子体射频电源系统从早期的基于变压器和电子管的射频电源及固定匹配网络演变成开关模式电源和自动调谐匹配网络，实现可靠、稳定、高效的功率输送，并极大地减小了物理尺寸；其后，等离子体射频电源系统逐渐向数模混合控制、全数字控制发展，输出信号也从连续波信号拓展出了脉冲信号。

随着平面器件结构尺寸逐渐接近物理极限，半导体行业开始转向更为复杂的三维结构，等离子体射频电源系统已经成为支持芯片 3D 结构复杂化的核心技术。3D 存储器的层数持续增加、FinFET 持续缩小对于等离子体射频电源系统的技术要求显著提升。如对于层数较高的 3D NAND，其刻蚀需要达到 70:1 的高深宽比，这要求等离子体中产生的活化离子能一直达到孔隙的底部，这需要等离子体射频电源系统通过产生多重射频和同步射频脉冲来控制离子能量和表面电荷，并且在微秒范围内精确测量、高速调谐射频功率。

2) AI 应用落地，半导体迎增长新机遇

人工智能（AI）的大量应用需求将带动新一轮半导体增长，尤其是先进制程的逻辑及存储相关的晶圆制造厂的产能。一方面，需求激增带动算力产业链的资本开支持续增加，并带动 HBM、3D NAND 存储需求快速增长。另一方面，随着手机、PC、汽车、物联网等传统终端的 AI 应用落地，换机和升级需求增加，智能装置 AI 化将推动新一轮半导体增长，成为本轮半导体增长周期的驱动因素。

3) 制程节点演进、芯片和工艺复杂度的提升带动等离子体射频电源系统用量及价值占比提升

半导体制造对等离子体射频电源系统工艺要求的提升，有效地丰富了等离子体射频电源系统的工艺体系，为设备厂商提供较宽的工艺窗口，并提高了等离子体射频电源系统在半导体制造设备中的价值占比。半导体设备全球市场规模成长至近千亿美元，同时随着制程节点不断演进、芯片和工艺复杂度的提升，薄膜沉积设备和刻蚀设备等半导体设备的需求将持续上升。等离子体射频电源系统作为薄膜沉积设备和刻蚀设备等半导体设备的核心零部件，其性能直接关系到薄膜沉积、刻蚀等环节中等离子体的浓度、均匀性和稳定性等，进而影响晶圆制造工艺的能力、良率和效率。薄膜沉积设备和刻蚀设备等单台设备中的等离子体射频电源系统的用量和价值占比随着半导体设备用量的增加也将呈整体提升态势。

4) 设备国产化为我国半导体行业发展的长期趋势

受欧美等国对我国半导体产业限制政策的影响，我国半导体产业的供应链安全面临严峻挑战，凸显出我国在半导体关键领域实现自主可控的必要性。半导体产业链国产化的需求特别强烈，国产化进程将进一步加速，半导体核心设备及核心零部件国产化将成为我国半导体行业发展的长期趋势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	901,088,728.31	817,674,296.61	10.20	628,347,757.31
归属于上市公司股东的净资产	800,252,958.64	679,967,506.09	17.69	537,025,614.14
营业收入	529,470,114.60	540,790,338.75	-2.09	325,268,486.91
利润总额	121,576,783.80	159,162,127.98	-23.61	87,635,123.63
归属于上市公司股东的净利润	113,840,339.46	141,540,222.60	-19.57	79,827,335.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,532,083.12	128,970,946.06	-18.95	68,533,819.12
经营活动产生的现金流量净额	84,787,796.09	99,500,225.57	-14.79	45,448,856.91
加权平均净资产收益率(%)	15.42	23.26	减少7.84个百分点	34.97
基本每股收益(元/股)	2.24	2.79	-19.71	1.62
稀释每股收益(元/股)	2.24	2.79	-19.71	1.62
研发投入占营业收入的比例(%)	15.14	10.22	增加4.92个百分点	11.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1.报告期内公司实现营业收入 529,470,114.60 元，较上年同期减少 2.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 113,840,339.46 元，较上年同期减少 19.57%。主要系半导体行业具有周期波动的特性，下游半导体设备客户的采购量需依据自身承接的晶圆厂订单数量、产品验证导入进度及交付验收

节奏动态调整，进而导致对公司的采购呈现波动。

2.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 84,787,796.09 元，较上年同期减少 14.79%，主要系本年度营业收入略降，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

3.报告期内研发投入占营业收入比例为15.14%，较上年度增加4.92个百分点。主要系公司研发费用中人工费同比增长61.43%，公司持续加大研发投入力度，提高技术指标要求，推进新产品开发、产品持续升级迭代等，不断加强产品竞争力，研发费用较上年同期大幅增加。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	141,519,897.79	162,536,445.24	97,257,351.16	128,156,420.41
归属于上市公司股东的净利润	35,029,013.79	34,318,601.03	22,229,092.77	22,263,631.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,672,800.40	32,090,327.75	20,596,013.92	19,172,941.05
经营活动产生的现金流量净额	15,334,185.36	-24,856,628.35	49,872,741.01	44,437,498.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		23					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		9,063					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）		0					
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

深圳市恒运昌投资有限公司	0	1,310.8051	25.8179	1,310.8051	无	0	境内非 国有法 人
乐卫平	0	1,172.1312	23.0866	1,172.1312	无	0	境内自 然人
深圳市恒运昌真空 技术投资中心（有 限合伙）	0	1,054.9592	20.7787	1,054.9592	无	0	其他
国投（广东）科技 成果转化创业投资 基金合伙企业（有 限合伙）	0	413.9245	8.1528	413.9245	无	0	其他
江苏瑞芯通宁半导 体产业投资基金合 伙企业（有限合 伙）	0	206.9622	4.0764	206.9622	无	0	其他
深圳市恒运昌投资 发展中心（有限合 伙）	0	161.9369	3.1895	161.9369	无	0	其他
拓荆科技股份有限 公司	0	156.6612	3.0856	156.6612	无	0	境内非 国有法 人
中电科核心技术研 发股权投资基金 （北京）合伙企业 （有限合伙）	0	77.1129	1.5188	77.1129	无	0	其他
上海浦宸私募投资 基金合伙企业（有 限合伙）	0	77.1129	1.5188	77.1129	无	0	其他
上海国策绿色科技 制造私募投资基金 合伙企业（有限合 伙）	0	56.5512	1.1138	56.5512	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末：</p> <p>（1）实际控制人乐卫平持有恒运昌投资 70% 股权，并担任恒运昌投资的执行董事，恒运昌投资是投资中心及投资发展中心的执行事务合伙人；恒运昌投资、投资中心及投资发展中心均为乐卫平控制的企业；</p> <p>（2）除上述情形外，公司未知其他股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

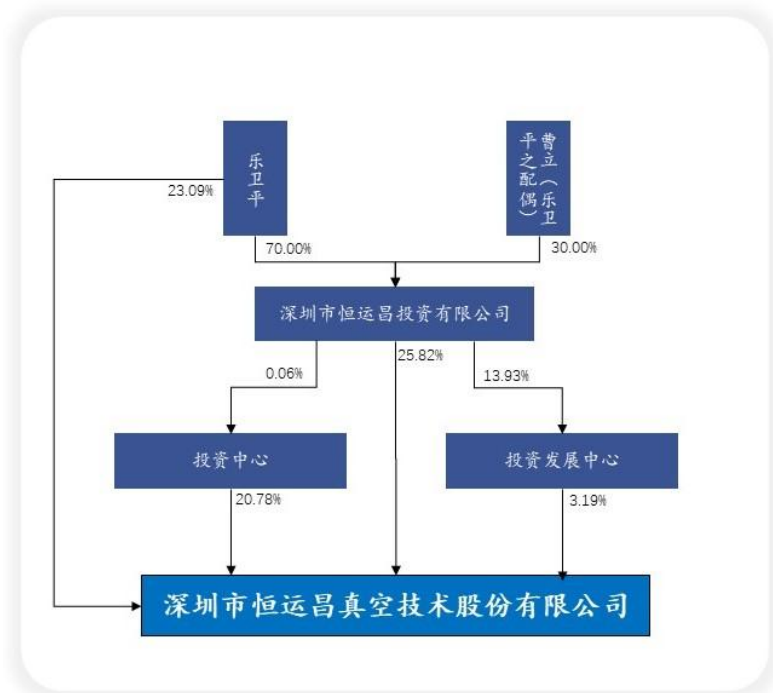
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

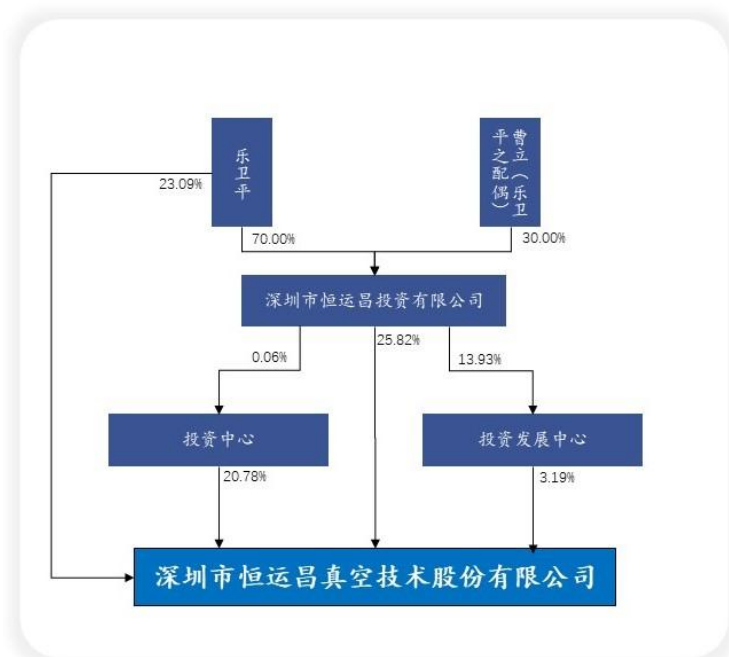
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入 52,947.01 万元，较上年同期下降 2.09%，主要系半导体行业具有周期波动的特性，下游半导体设备客户的采购量需依据自身承接的晶圆厂订单数量、产品验证导入进度及交付验收节奏动态调整，进而导致对公司的采购呈现波动。实现归属于上市公司股东的净利润 11,384.03 万元，较上年同期下降 19.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,453.21 万元，较上年同期下降 18.95%，主要系公司持续加大研发投入力度，提高技术指标要求，推进新产品开发、产品持续升级迭代等，不断加强产品竞争力，研发费用较上年同期大幅增加。截至本报告披露日，公司在手订单为 15,718.77 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用